参 数 表

HVP-16 高压二极管采用高可靠性的台面结构及扩散工艺，环氧树脂真空灌注密闭封装。

HVP-16 High voltage diode adopts high reliable mesa structure and diffusion craftwork, epoxy resin molded in a compact structure.

▼ 产品特点 Feature

- ❖ 雪崩电压击穿保护特性 **Avalanche Characteristic**
- ❖ 优异的抗浪涌电流冲击特性 **Excellent surge current resistance**
- ❖ 高速开关响应特性 **High speed switch response characteristics**
- ❖ 采用新型环氧树脂真空封装技术，表面具有抗腐蚀性
  Epoxy resin molded in vacuum, have anticorrosion in the surface
- ❖ 工作结温-50℃—+150℃ **Tj:50℃—+150℃**
- ❖ 特殊耐高温性能芯片，可承受严酷恶劣的使用条件
  Special high temperature resistant chip that can withstand harsh working conditions

▼ 产品 2D 图示 Graphical Representation

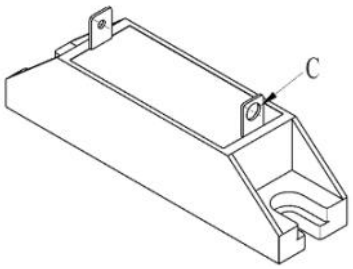
HVDIODE

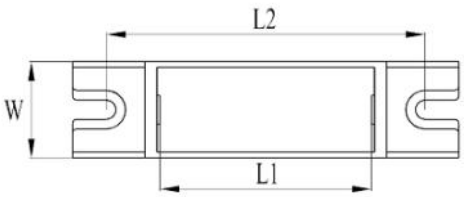
	参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions	数值 Rating
极限值（绝对最大值） Absolute Maximum Ratings	反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	KV	Ta=25℃ I_R=2.0μA	16
	反向工作峰值电压 ） Peak Working Revere Voltage	V_{RWM}	KV	Ta=25℃ I_R=2.0μA	16
	正向平均电流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	正弦半波 50Hz，电阻负载，T_{break}=50℃ （ 50Hz Half-sine Wave ， Resistance load @T_{break}=50℃ ）	1.0
	反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	nS		--
	正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current	I_{FSM}	A	正弦半波持续时间 0.01S 50Hz 0.01S @ Half-Sine wave 50Hz	40
	工作环境温度 Operating Ambient Temperature	T_a	℃		-40 ~ +150
	存贮温度 Storage Temperature	T_{stg}	℃		-40 ~ +120
电特性 Electrical Characteristics	正向峰值电压 Forward Peak Voltage	V_{FM}	V	@ Ta=25℃ I_F=1A	20
	反向峰值电流 Peak Reverse Current	I_{RRM1}	μA	@ Ta=25℃ V_{RM}=V_{RRM}	2.0
		I_{RRM2}	μA	@ Ta=100℃ V_{RM}=V_{RRM}	20.0

▼外形尺寸图示 Outline Drawings（单位：毫米 mm）

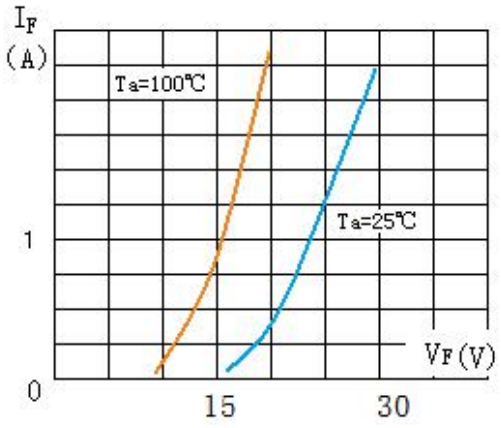
图号/尺寸	Fig②
长(L)	80
宽(W)	20
高(H)	20
极距（L1）	45
定位孔距(L2)	70
插片	8*15

Fig②

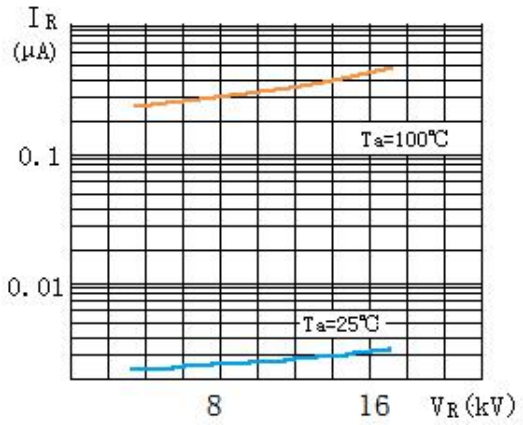




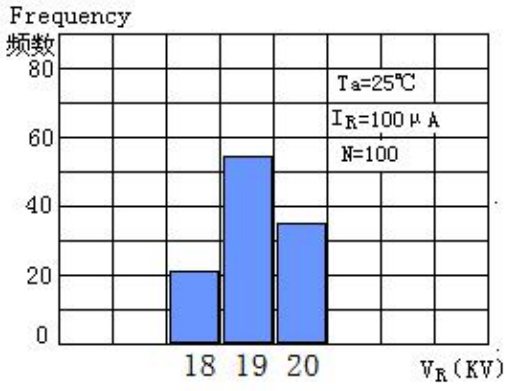
▼ 特性曲线图 Characteristic Curve



正向特性曲线（HVP-16）
Forward Characteristics



反向特性曲线（HVP-16）
Reverse Characteristics



反向雪崩电压分布（HVP-16）
Avalanche Breakdowm Voltage Distribution